

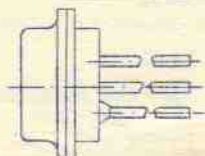
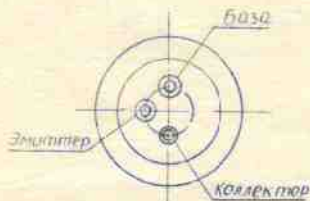


Транзисторы 2Т312А,
2Т312В,
2Т312В

ЭТИКЕТКА

Кремниевые эпитаксиально-планирные п-р-п транзисторы типов 2Т312А, 2Т312В, 2Т312В в металлоглазном корпусе, предназначенные для работы в аппаратуре специального назначения.

Климатическое исполнение общиное.



Масса не более 1г.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25°C

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенные обозначения	Норма					
		2Т312А		2Т312В		2Т312В	
		не менее	более	не менее	более	не менее	более
I	2	3	4	5	6	7	8
Обратный ток коллектора, мкА ($U_{кз} = 30В$)	$I_{к50}$		1		1		1
Статический коэффициент переноса тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кз} = 2В, I_{с} = 20мА, R = 10-100, f = 50-1000Гц$)	$h_{21э}$	12	100	25	100	50	250
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_{к} = 20мА, I_{с} = 2мА$)	$U_{кэнас}$		0,5		0,5		0,35
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{кз} = 10В, I_{с} = 5мА, f = 20МГц$)	$ h_{21э} $	4		6		6	

T	2	3	4	5	6	7	8
Постоянная времени (при обратной связи по $V_{ce}=10В, I_3=5мА, f=5МГц$)	Z_k		500		500		500
Обратный ток эмиттера, мкА ($V_{ce}=4В$)	I_{300}		10		10		10
Время рассасывания, нс ($I_k=20мА, I_{01}=2мА, I_{02}=14мА$)	$t_{рас}$		100		130		130
Скорость коллекторного перехода, пс ($V_{ce}=10В, f=5МГц$)	C_k		5		5		5
Скорость эмиттерного перехода, пс ($V_{ce}=1В, f=5МГц$)	C_3		20		20		20
Напряжение насыщения база-эмиттер, В ($I_k=20мА, I_3=2мА$)	$V_{кэнт}$		1,1		1,1		1,1
Граничное напряжение, В ($V_{кв}=30В, I_3=7,5мА$)	$V_{квкп}$	30		30		30	

СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ:

Золото 10,027 мг

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы типа 2Т312А, 2Т312Б, 2Т312В соответствуют техническим условиям ЭК3.365.143 ТУ и габаритному чертежу ЭК3.365.143 ГЧ.

Принято по извещению № 274 от 12-04

